**Nazwa przedmiotu:**

Technologia wyrobów elektronicznych I

**Koordynator przedmiotu:**

Dr inż. Ryszard Jezior, docent

**Status przedmiotu:**

Obowiązkowy

**Poziom kształcenia:**

Studia I stopnia

**Program:**

Mechatronika

**Grupa przedmiotów:**

Obowiązkowe

**Kod przedmiotu:**

TWE I

**Semestr nominalny:**

6 / rok ak. 2012/2013

**Liczba punktów ECTS:**

4

**Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:**

Wykład 30, laboratorium 15, przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 15, opracowanie sprawozdań 10, zapoznanie z literaturą 15, przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie 20.
Razem 105 godz. = 4 ECTS

**Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:**

Wykład 30, ćwiczenia w laboratorium 15.
Razem 45 godz. = 1,5 ECTS

**Język prowadzenia zajęć:**

polski

**Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:**

Obecność w laboratorium 15, przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 15, opracowanie sprawozdań 10, zapoznanie z literaturą 15.
Razem 55 godz. = 2 ECTS

**Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykład: | 30h |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

**Wymagania wstępne:**

Znajomość materiałoznawstwa, podstaw technik wytwarzania.

**Limit liczby studentów:**

30

**Cel przedmiotu:**

Znajomość rozwiązań konstrukcyjnych i procesów technologicznych elementów czynnych i biernych oraz podzespołów elektronicznych.

**Treści kształcenia:**

W. : Wprowadzenie. Podstawy technologii elementów półprzewodnikowych. Technologia cienko- i grubowarstwowych, hybrydowych układów scalonych. Technologia elementów biernych. Wytwarzanie obwodów drukowanych. Montaż zespołów elektronicznych i komputerowych.
L. : Zasady wytwarzania cienkowarstwowych układów hybrydowych. Analiza procesu lutowania. Zasady obróbki fotochemicznej obwodów drukowanych. Zasady wiercenia otworów w płytach obwodów drukowanych. Zasady montażu powierzchniowego obwodów drukowanych. Zasady wykonywania mikropołączeń drutowych metodą ultrakompresji. Zasady zautomatyzowanego montażu.

**Metody oceny:**

Egzamin po VI semestrze

**Egzamin:**

tak

**Literatura:**

1. Praca zbiorowa: Procesy technologiczne w elektronice półprzewodnikowej, WNT, Warszawa 1987
2. Witold Rosiński: Wszystko o krzemie, Wyd. CEMAT, 1987
3. Ryszard Kisiel: Podstawy technologii dla elektroników. Poradnik praktyczny, Wyd. BTC, Warszawa 2005

**Witryna www przedmiotu:**

**Uwagi:**

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

**Efekt TWE I\_W01:**

Posiada wiedzę w zakresie podstawowych procesów stosowanych w wytwarzaniu elementów półprzewodnikowych: monokrystalizacji, obróbki mechanicznej monokryształów, epitaksji, wytwarzania warstw dielektrycznych, fotolitografii, dyfuzji, implantowania jonów, wytwarzania metalizacji, montażu oraz hermetyzacji. Posiada także wiedzę z zakresu wytwarzania układów scalonych, hybrydowych cienko- i grubowarstwowych, w szczególności druku sitowego i obróbki termicznej nadrukowanych warstw. Posiada znajomość procesów wytwórczych elementów biernych: rezystorów, kondensatorów i elementów indukcyjnych.

Weryfikacja:

Egzamin

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_W02, K\_W07, K\_W16, K\_W17

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_W01, T1A\_W03, T1A\_W04, T1A\_W03, T1A\_W04, T1A\_W05

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

**Efekt TWE I\_U01:**

Potrafi zaprojektować określony proces technologiczny elektronicznego elementu czynnego lub biernego, dobrać parametry technologiczne poszczególnych operacji,dobrać materiały lub półfabrykaty niezbędne do realizacji tego procesu.

Weryfikacja:

Egzamin i zaliczenie laboratorium

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_U01, K\_U02, K\_U03, K\_U05, K\_U07, K\_U11, K\_U20

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_U01, T1A\_U02, T1A\_U07, T1A\_U04, T1A\_U05, T1A\_U09, T1A\_U02, T1A\_U08, T1A\_U09, T1A\_U16

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

**Efekt TWE I\_K01:**

Potrafi pracować w zespole podczas planowania i realizacji zadania inżynierskiego.

Weryfikacja:

Zaliczenie laboratorium

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_K01, K\_K03, K\_K04, K\_K05

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_K01, T1A\_K02, T1A\_K07, T1A\_K03, T1A\_K04, T1A\_K05, T1A\_K06